

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Juli 2003 (03.07.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

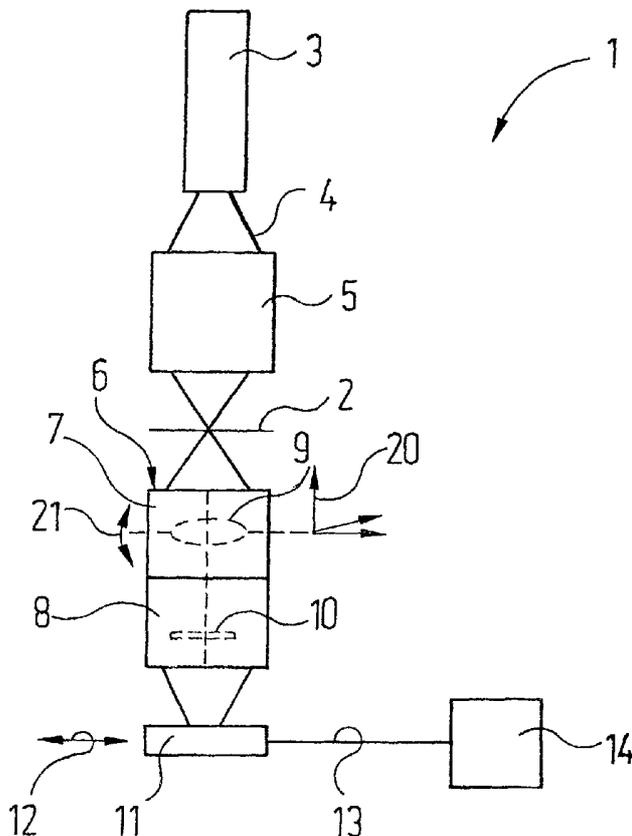
WO 03/054631 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G03F 7/20, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von G02B 5/30, 1/02, 1/08 US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/11030
- (22) Internationales Anmeldedatum: 2. Oktober 2002 (02.10.2002) (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MECKING, Birgit [DE/DE]; Milanweg 107, 73434 Aalen (DE). GRUNER, Toralf [DE/DE]; Moosstr. 5, 89551 Königsbronn (DE). KOHL, Alexander [DE/DE]; Zeppelinstrasse 1, 73430 Aalen (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 101 62 796.3 20. Dezember 2001 (20.12.2001) DE (74) Anwälte: OSTERTAG, Ulrich usw.; Eibenweg 10, 70597 Stuttgart (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OPTIMIZING THE IMAGING CHARACTERISTICS OF AT LEAST TWO OPTICAL ELEMENTS AND PHOTOLITHOGRAPHIC PRODUCTION PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR OPTIMIERUNG DER ABBILDUNGSEIGENSCHAFTEN VON MINDESTENS ZWEI OPTISCHEN ELEMENTEN SOWIE PHOTOLITHOGRAPHISCHES FERTIGUNGSVERFAHREN



(57) Abstract: The invention relates to a method for optimizing the imaging characteristics of at least two optical elements (9, 10) wherein the relative position of the optical elements (9,10) is adjusted in order to optimize the optical imaging in relation thereto. The inventive method consists of the following steps: a polarization-dependent disturbance variable is initially determined for at least one element (9, 10). A target position of at least one movable optical element (9) is calculated from the disturbance variable determined therefor and the disturbance variables of the other optical elements. In the target position, the overall variable for all optical elements (6), comprising polarization-dependent and polarization-independent disturbance variables is minimized. The movable optical element (9) is then moved into said target position. Precise modelling of the imaging characteristics is achieved by taking into account the polarization-dependent disturbance variable, thereby creating the requisite precondition for exact optimization.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften von mindestens zwei optischen Elementen (9, 10), bei dem die relative Lage der optischen Elemente (9, 10) zur Optimierung der optischen Abbildung zueinander eingestellt wird, werden folgende Verfahrensschritte durchgeführt: Zunächst wird eine polarisationsabhängige

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 03/054631 A1



(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Störgrösse für mindestens ein optisches Element (9, 10) bestimmt. Anschliessend wird eine Zielposition mindestens eines beweglichen optischen Elements (9) aus der für dieses bestimmten Störgrösse und den Störgrössen der weiteren optischen Elemente berechnet. In welcher dieser Zielposition ist die Gesamtgrösse aller optischen Elemente (6), zusammengesetzt aus polarisationsabhängigen und polarisationsunabhängigen Störgrössen, minimiert. Schliesslich wird das bewegliche optische Element (9) in die Zielposition bewegt. Die Berücksichtigung der polarisationsabhängigen Störgrösse gewährleistet eine präzise Modellierung der Abbildungseigenschaften, welche die Voraussetzung für eine exakte Optimierung ist.

Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften
von mindestens zwei optischen Elementen sowie
photolithographisches Fertigungsverfahren

=====

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften von mindestens zwei optischen Elementen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein photolithographisches Fertigungsverfahren.

Derartige Verfahren sind aus der EP 1 063 684 A1 bekannt. Dort wird als polarisationsabhängige Störgröße die Doppelbrechungsverteilung von Linsen innerhalb eines Projektionsobjektivs einer Projektionsbelichtungsanlage bestimmt. Die Linsen werden dann so ausgewählt und innerhalb des Projektionsobjektivs angeordnet, daß sich eine Gesamtdoppelbrechung ergibt, deren Betrag für jeden optischen Weg durch das Projektionsobjektiv einen vorgegebenen Grenzwert unterschreitet. Die Gesamtdoppelbrechung setzt sich hierbei zusammen aus der Summe aller Doppelbrechungen der einzelnen vermessenen Linsen. Ein derartiges Verfahren ist hilfreich, wenn Linsen aufgrund einer nicht tolerierbaren Doppelbrechungsverteilung aussortiert werden sollen, führt in der Praxis jedoch nicht immer dazu, daß Vorgabewerte für die Abbildungseigenschaften der optischen Elemente erreicht werden.

Ein anderes Optimierungsverfahren ist aus dem Fachartikel "The development of microlithographic high-performance optics, Int. J. of Optoelec., 1989, 545, bekannt. Bei der Optimierung der Abbildungseigenschaften optischer Systeme mit optischen Elementen, die aus Kristallmaterialien gefertigt sind, führt dieses Verfahren nur dann

zu zufriedenstellenden Ergebnissen, wenn die Kristallmaterialien speziell ausgewählt werden und die optischen Elemente spannungsfrei gehaltert werden. Derartige Maßnahmen sind aufwendig.

05

Es ist daher eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Optimierungsverfahren der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass ein Gesamtabbildungsfehler, der sich aus den Abbildungsfehlern der einzelnen optischen Komponenten zusammensetzt, für die meisten praktischen Anwendungsfälle weiter reduziert werden kann.

10

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren stützt sich auf folgende Erkenntnisse:

Zur Gesamtstörgröße tragen in aller Regel polarisationsabhängige und polarisationsunabhängige Störgrößen bei. Polarisationsabhängige Störgrößen können unterteilt werden in intrinsisch vorliegende polarisationsabhängige Störgrößen wie der intrinsischen, also auch bei homogenem und spannungsfreiem Material auftretenden, Doppelbrechung, in aufgrund externer Effekte auftretende polarisationsabhängige Störgrößen wie der Spannungsdoppelbrechung und in aufgrund innerer Materialinhomogenitäten auftretende polarisationsabhängige Störgrößen wie einer Doppelbrechung aufgrund von Kristallfehlern, insbesondere durch die Ausbildung von Domänen im Material.

20
25
30

Bisherige Bestimmungsverfahren zur Bestimmung von Abbildungsfehlern optischer Elemente beschränkten sich in der Regel auf polarisationsunabhängige Störgrößen, da für die gebräuchlichen optischen Materialien nur im Ausnahmefall

35

von einer polarisationsabhängigen Störgröße ausgegangen wurde. Diesen polarisationsabhängigen Störgrößen wurde bisher Rechnung getragen, ohne sie in eine Zielpositionsberechnung einzubinden. Dies geschah, wie oben schon
05 erwähnt, durch Materialauswahl bzw. spezielle Halterung.

Aus der Internet-Publikation "Preliminary Determination of an Intrinsic Birefringence in CaF_2 " von J. H. Burnett, G. L. Shirley und Z. H. Levine, NIST Gaithersburg MD 20899
10 USA (verbreitet am 7.5.01), ist jedoch bekannt, dass CaF_2 Einkristalle auch nicht spannungsinduzierte, also intrinsische Doppelbrechung aufweisen. Dies gilt zum Beispiel für eine Strahlausbreitung in der (110)-Kristallrichtung. Bei einer Strahlausbreitung in der (100)-Kristallrichtung
15 und in der (111)-Kristallrichtung weist CaF_2 dagegen keine intrinsische Doppelbrechung auf. Die auftretende Doppelbrechung ist also strahlrichtungsabhängig. Sie kann weder durch Materialauswahl noch durch eine spannungsfreie Halterung eines optischen Elements eliminiert werden.

20 Da CaF_2 und auch andere Kristallmaterialien mit intrinsischer Doppelbrechung zunehmend als optische Materialien insbesondere in Verbindung mit UV-Lichtquellen eingesetzt werden, führt das Nichtberücksichtigen polarisationsabhängiger Störgrößen zu Abbildungsfehlern, die bei den
25 bekannten Optimierungsverfahren nicht erfaßt werden.

Die polarisationsabhängigen Störgrößen führen dazu, dass eine Abbildung von Lichtstrahlen orthogonaler Polarisationen an unterschiedlichen Orten erfolgt. Gleichzeitig
30 können Polarisierungseffekte bewirken, daß die einzelnen Polarisationskomponenten unterschiedliche Abbildungsfehler erfahren.

35 Die oben erwähnte EP 1 063 684 A1 berücksichtigt zwar

eine polarisationsabhängige Störgröße, nämlich die Doppelbrechung, läßt aber im Rahmen der Optimierung der Anordnung der optischen Komponenten zueinander andere Störgrößen außer acht, wodurch sich vermeidbare Fehlerbeträge zum
05 Gesamtabbildungsfehler ergeben können.

Erfindungsgemäß werden sowohl die polarisationsabhängigen als auch die polarisationsunabhängigen Störgrößen bei der Zielpositionsberechnung berücksichtigt. Auf diese
10 Weise lassen sich die optischen Elemente hinsichtlich ihrer Abbildungseigenschaften präzise und vollständig modellieren.

Die polarisationsabhängige Störgröße gemäß Anspruch
15 2 berücksichtigt den Einfluss von internen Spannungen in den optischen Materialien. Diese internen Spannungen können etwa beim Herstellungsprozess im Material eingefroren worden sein oder aufgrund der mechanischen Halterung (Fassung) des optischen Elements auftreten. Die
20 Berücksichtigung der Spannungsdoppelbrechung verbessert die Optimierung der Abbildungseigenschaften auch bei optischen Elementen, die keine intrinsische Spannungsdoppelbrechung aufweisen.

Eine Lagebestimmung mindestens einer Kristallachse gemäß
25 Anspruch 3 kann im günstigsten Fall, wenn keine weiteren polarisationsabhängigen Störgrößen vorliegen, eine weitere Messung polarisationabhängiger Störgrößen überflüssig machen, da nach Bestimmung der Kristallachsenlage die
30 intrinsische Doppelbrechung berechnet werden kann.

Ein relativ einfach, da ohne größere Eingriffe in die Halterung des optischen Elements, realisierbarer Bewegungsfreiheitsgrad ist die Verdrehbarkeit des mindestens
35 einen optischen Elements gemäß Anspruch 4.

Die Auswirkungen der Verlagerung eines gemäß Anspruch
5 linear verlagerbaren optischen Elements auf die Abbil-
dungseigenschaften der mindestens zwei optischen Elemente
05 lassen sich präzise, z.B. mittels optischer Designprogramme
vorhersagen, was die Berechnung der Zielposition erleich-
tert.

Mit einem gemäß Anspruch 6 verlagerbaren optischen Element
10 lassen sich insbesondere Zentrierungsfehler kompensieren.

Ein gemäß Anspruch 7 verkipptes optisches Element
erlaubt z.B. eine Ausrichtung der Kristallachsen des
optischen Elements relativ zur optischen Achse einer
15 Gesamtoptik, welche die mindestens zwei optischen Elemente
umfaßt.

Eine Bestimmung der polarisationsabhängigen Störgröße
gemäß Anspruch 8 führt dazu, dass auch die Beiträge
20 der Spannungsdoppelbrechung, die von der Fassung ausgehen
bei der Bestimmung der polarisationsabhängigen Störgröße
berücksichtigt werden. Dies erhöht die Präzision des
Optimierungsverfahrens.

25 Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein photolithographisches Fertigungsverfahren mit
verbesserter optischer Qualität schaffen.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch ein Ver-
30 fahren mit den im Anspruch 9 genannten Merkmalen. Die
Vorteile des Fertigungsverfahrens ergeben sich aus den
oben diskutierten Vorteilen des Optimierungsverfahrens.

Bei einer Belichtungswellenlänge gemäß Anspruch 10 liegen
35 bei vielen optischen Materialien polarisationsabhängige

Störgrößen vor, die die Abbildungseigenschaften optischer Elemente stärker beeinflussen als z.B. bei Belichtung mit sichtbarem Licht. Bei einer Belichtung mit Wellenlängen kleiner als 200 nm kommt daher das erfindungsgemäße
05 Optimierungsverfahren stark zum Tragen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

- 10 Figur 1 eine Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie;
- Figur 2 einen Schnitt durch einen Block eines Einkristalls als Ausgangsmaterial für eine Linse einer Projektionsoptik der Projektionsbelichtungsanlage von
15 Figur 1;
- Figur 3 eine schematische Darstellung der intrinsischen Doppelbrechung einer aus einem Einkristall
20 hergestellten optischen Platte der Projektionsoptik der Projektionsbelichtungsanlage von Figur 1;
- Figur 4 ein Koordinatensystem zur Definition eines
25 Öffnungswinkels und eines Azimutwinkels für Strahlen eines Projektionslichtbündels der Projektionsbelichtungsanlage von Figur 1; und
- Figur 5 den Verlauf der intrinsischen Doppelbrechung der
30 optischen Platte von Figur 3 in Abhängigkeit vom Azimutwinkel.

Eine in Figur 1 insgesamt mit 1 bezeichnete Projektionsbelichtungsanlage dient zur Übertragung einer Struktur
35 von einer Maske 2 auf einen in der Figur 1 nicht darge-

stellten Wafer.

Eine Lichtquelle 3, zum Beispiel ein F_2 -Laser bei mit einer Wellenlänge 157nm, erzeugt hierzu ein Projektionslichtbündel 4. Dieses durchtritt zur Formung zunächst eine Beleuchtungsoptik 5 und anschließend die Maske 2. Eine Projektionsoptik 6 bildet die auf der Maske 2 vorliegende Struktur auf den Wafer ab.

10 Die Projektionsoptik 6 ist in Figur 1 unterteilt in einen um die optische Achse der Projektionsoptik 6 verdrehbaren Teil 7 und in einen stationären Teil 8. In der Praxis liegen bei der Projektionsoptik 6 oft mehrere verdrehbare Teile vor; zu Zwecken dieser Beschreibung genügt jedoch die
15 Beschränkung auf nur einen verdrehbaren Teil 7.

Stellvertretend für die optischen Komponenten des verdrehbaren Teils 7 ist in Figur 1 eine bikonvexe Linse 9 und für die optischen Komponenten des stationären Teils 8
20 eine planparallele optische Platte 10 angedeutet. Die Linse 9 ist zudem, wie in Fig. 1 durch ein kartesisches Koordinatensystem 20 illustriert, sowohl längs der optischen Achse als auch quer zur optischen Achse der Projektionsoptik 6 verlagerbar, sowie, wie durch einen Doppelpfeil 21 in Fig. 1 angedeutet, gegenüber der optischen
25 Achse der Projektionsoptik 6 verkippar. Der Doppelpfeil 21 bezeichnet hierbei eine von zwei möglichen und aufeinander senkrecht stehenden Kippbewegungen gegenüber der optischen Achse. Auch andere, in Fig. 1 nicht explizit
30 dargestellte optische Elemente der Projektionsoptik 6 können die genannten Bewegungsfreiheitsgrade aufweisen.

Zur Vermessung von sich auf die Abbildungseigenschaften der Projektionsoptik 6 auswirkenden Störgrößen ist ein
35 positionsempfindlicher Sensor 11 vorgesehen. Dieser ist

quer zur optischen Achse der Projektionsoptik 6 zwischen einer in Figur 1 dargestellten Messposition und einer nicht dargestellten, aus dem Strahlengang des Projektionslichtbündels 4 herausverlagerten Projektionsbelichtungsposition verschiebbar (vgl. Doppelpfeil 12 in Fig. 1). Über eine Signalleitung 13 steht der Sensor 11 mit einem Rechner 14 in Verbindung.

Die Linse 9 und die optische Platte 10 sind aus Einkristallen aus CaF_2 gefertigt, welches eine kubische Kristallsymmetrie aufweist. Zur Herstellung werden diese optischen Elemente 9, 10 aus Kristallblöcken herausgeschnitten und poliert.

Für die Linse 9 ist in Fig. 2 beispielhaft ein solcher Kristallblock 15 dargestellt. Dieser ist so orientiert, dass (100)-Kristallebenen 16 derart senkrecht auf der Zeichenebene stehen, daß ihre Schnittgeraden mit der Zeichenebene horizontal verlaufende Linien ergeben. Die Linse 9 wird aus dem Kristallblock 15 so herausgearbeitet, dass ihre Elementachse EA, d. h. die optische Achse der Linse 9, mit der (100)-Kristallrichtung, die senkrecht auf den (100)-Kristallebenen steht, zusammenfällt.

Auch die optische Platte 10, die isoliert in Fig. 3 dargestellt ist, ist derart orientiert aus einem Kristallblock herausgearbeitet. Dort sind neben der (100)-Kristallrichtung auch die (101)-, (110)-, (10-1)- und (1-10)-Kristallrichtungen als Pfeile dargestellt, wobei das negative Vorzeichen bei der Indizierung der Kristallrichtung in dieser Beschreibung der Bezeichnung "oben quer" in der Zeichnung gleichzusetzen ist. Eine intrinsische Doppelbrechung der optischen Platte 10 ist schematisch durch vier "Keulen" 17 dargestellt, deren Oberflächen den Betrag der intrinsischen Doppelbrechung für die jeweilige

Strahlrichtung eines Lichtstrahls des Projektionslichtbündels 4 (vgl. Figur 1) angeben. Die maximale intrinsische Doppelbrechung der optischen Platte 4 ergibt sich jeweils in den (101)-, (110)-, (10-1) und (1-10)-Kristallrichtungen.

05

Die Strahlrichtung eines Lichtstrahls 18 des Projektionslichtbündels 4 ist durch einen Öffnungswinkel Θ und einen Azimutwinkel α definiert. Die Lage dieser beiden Winkel verdeutlicht Figur 4: Dort ist ein kartesisches Koordinatensystem der Projektionsbelichtungsanlage 1 gezeigt, dessen z-Achse mit der optischen Achse der Projektionsoptik 6 zusammenfällt. Der Öffnungswinkel Θ ist der Winkel zwischen dem Lichtstrahl 18 und der z-Achse. Der Azimutwinkel α ist der Winkel zwischen der x-Achse und der Projektion des Lichtstrahls 18 auf die xy-Ebene.

15

Bei der nachfolgenden Beschreibung sind die optischen Komponenten 9, 10 so orientiert, daß die (100)-Kristallrichtung mit der z-Achse und die Projektion der (101)-Kristallrichtung auf die xy-Ebene mit der x-Achse zusammenfällt.

20

Figur 5 zeigt die intrinsische Doppelbrechung (IDB) der optischen Platte 10 in Abhängigkeit vom Azimutwinkel α für den Öffnungswinkel $\Theta = 45$ Grad. Es ergibt sich eine vierzählige Symmetrie, wobei die Maxima der intrinsischen Doppelbrechung sich für Lichtstrahlen ergeben, deren Strahlrichtung mit den (101)-, (110)-, (10-1)- und (1-10)-Kristallrichtungen (vgl. Figur 3) zusammenfallen, also für Lichtstrahlen mit einem Öffnungswinkel Θ von 45 Grad und einem Azimutwinkel α von 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad und 270 Grad. Die intrinsische Doppelbrechung verschwindet (vgl. Figur 3) bei einem Öffnungswinkel von 0 Grad, d. h. eine Strahlrichtung längs der optischen Achse des Projektionsobjektivs 6 in (100)-Kristallrichtung.

35

- 10 -

Als maximale intrinsische Doppelbrechung (Strahlausbreitung z.B. in (110)-Kristallrichtung, d.h. Theta gleich 45 Grad, Alpha gleich 90 Grad) wurde ein Wert von (11,0 +/- 0,4) 05 nm/cm bei einer Wellenlänge von 156,1nm für CaF₂ gemessen.

Bei den Azimutwinkeln, bei denen eine intrinsische Doppelbrechung auftritt (vgl. Figur 5), nimmt diese für Öffnungswinkel kleiner als 45 Grad mit dem Öffnungswinkel kontinuierlich ab (vgl. Figur 3). 10

Neben diesen intrinsischen Beiträgen zur Doppelbrechung weisen die Linse 9 und die optische Platte 10 abhängig von ihrer Einbausituation in der Projektionsoptik 6 15 zusätzliche Spannungsdoppelbrechungsbeiträge auf, die sich zur intrinsischen Doppelbrechung addieren. Weitere Doppelbrechungsbeiträge können sich zum Beispiel durch Kristallfehler, insbesondere durch die Ausbildung von Domänen, ergeben. Nicht intrinsische Doppelbrechungsbeiträge können auch bei optischen Materialien vorliegen, die keine intrinsische Doppelbrechung aufweisen. 20

Ein Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften der Projektionsoptik 6 wird folgendermaßen durchgeführt: 25

Zunächst werden die optischen Störgrößen aller optischen Elemente der Projektionsoptik 6 einzeln ermittelt. Derartige Messverfahren zur Bestimmung einerseits der oben beschriebenen Doppelbrechungsbeiträge als Beispiel für 30 polarisationsabhängige Störgrößen und andererseits polarisationsunabhängiger Störgrößen sind dem Fachmann bekannt. Hierzu kann zum Beispiel, wie dies durch den Sensor 11 in Figur 1 angedeutet ist, eine Messung der Gesamtabbildungseigenschaften der Projektionsoptik 6 bei verschiedenen 35 Justagezuständen der Projektionsoptik 6 erfolgen.

Alternativ oder zusätzlich können mit Hilfe bekannter Messverfahren die einzelnen optischen Elemente der Projektionsoptik 6 unabhängig voneinander vermessen werden.

05 Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Einbausituation der optischen Elemente in der Projektionsoptik 6 während dieser unabhängigen Vermessung möglichst präzise simuliert wird, so dass bedingt durch den Einbau der optischen Elemente in die Projektionsbelichtungsanlage

10 1 nicht zusätzliche Störbeiträge entstehen, die die Optimierung der Abbildungseigenschaften der Projektionsoptik 6 beeinträchtigen.

Die Bestimmung der Doppelbrechungsbeiträge kann zum

15 Beispiel die Lagebestimmung der Kristallachsen der vermessenen optischen Elemente, soweit es sich um Kristallmaterialien handelt, umfassen.

Die Messergebnisse werden vom Rechner 14 ausgewertet.

20 Dieser ermittelt die jeweiligen Störgrößenbeiträge der einzelnen optischen Elemente der Projektionsoptik und ordnet diese Beiträge den einzelnen polarisationsabhängigen und polarisationsunabhängigen Störgrößen zu. Anschließend berechnet und optimiert der Rechner 14 eine Zielfunktion

25 (Meritfunktion). In diese Zielfunktion gehen die Abhängigkeiten der Störgrößenbeiträge aller optischen Elemente von den Bewegungsfreiheitsgraden dieser optischen Elemente (Verdrehung, Neigung, Zentrierung) ein.

30 Im dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt diese Berechnung für die optischen Komponenten 9 und 10:

Wie oben ausgeführt, ist die Linse 9 gegenüber der optischen Platte 10 um die optische Achse verdrehbar. Nach

35 der Vermessung der Störgrößenbeiträge liegen für die Linse

9 und die optische Platte 10 ihre jeweiligen Beiträge zu den polarisationsabhängigen und den polarisationsunabhängigen Störgrößen vor. Die Meritfunktion enthält neben den Störgrößen der Linse 9 und der optischen Platte 10 auch
05 die Abhängigkeit der Störgrößenbeiträge der Linsen 9 von der Verdrehung von dieser um die optische Achse.

Anschließend wird die Meritfunktion durch Variation der Bewegungsfreiheitsgrade der beweglichen Teile der Projektionsoptik 6 optimiert. Bei der Ausführung gemäß Figur 1
10 wird die Meritfunktion bei jeder Drehposition des verdrehbaren Teils 7 der Projektionsoptik 6 ausgewertet. Anschließend wird diejenige Drehposition ermittelt, in der die Meritfunktion den optimalen Wert aufweist.

15

Schließlich werden die beweglichen optischen Elemente in die ermittelte Zielposition gefahren. Bei der Ausführung nach Figur 1 wird der verdrehbare Teil 7 mit der Linse 9 in die ermittelte Zielposition gedreht.

Patentansprüche

=====

05

1. Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften von mindestens zwei optischen Elementen, bei dem die relative Lage der optischen Elemente zur Optimierung der optischen Abbildung zueinander eingestellt wird, mit folgenden Verfahrensschritten:

- 10 a) Bestimmen einer polarisationsabhängigen Störgröße für mindestens ein optisches Element (9, 10);
- 15 b) Berechnen einer Zielposition mindestens eines beweglichen optischen Elements (9) aus den Störgrößen, die für dieses und für das mindestens eine weitere optische Element bestimmt wurden,
- 20 c) Bewegen des beweglichen optischen Elements (9) in die Zielposition;

dadurch gekennzeichnet, daß

25 das Berechnen der Zielposition derart erfolgt, daß in der Zielposition die Gesamtstörgröße aller optischen Elemente (9, 10), zusammengesetzt aus polarisationsabhängigen und polarisationsunabhängigen Störgrößen, minimiert ist.

30 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass unter den polarisationsabhängigen Störgrößen die Spannungsdoppelbrechung ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine optische Element (9, 10),

35

dessen polarisationsabhängige Störgröße bestimmt wird,
aus einem Kristallmaterial besteht und dass das Bestimmen
der aus der Spannungsdoppelbrechung resultierenden
Störgröße das Bestimmen der Lage mindestens eine Kristall-
05 achse umfasst.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
bewegliche optische Element (9) um seine optische Achse
10 verdrehbar ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
bewegliche optische Element relativ zu den anderen opti-
15 schen Elementen linear verlagerbar ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das bewegliche optische Element quer zur optischen
Achse verlagerbar ist.

20

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das bewegliche optische Element
gegenüber der optischen Achse verkippar ist.

25 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der
polarisationsabhängigen Störgröße am gefassten optischen
Element erfolgt.

30 9. Photolithographisches Fertigungsverfahren für Halb-
leiterbauelemente unter Benutzung optischer Elemente,
deren Abbildungseigenschaften mit einem Verfahren nach
einem der vorhergehenden Ansprüche optimiert wurden.

35 10. Photolithographisches Fertigungsverfahren nach Anspruch
9, gekennzeichnet durch eine Projektionsbelichtung
mit einer Wellenlänge, die geringer ist als 200 nm.

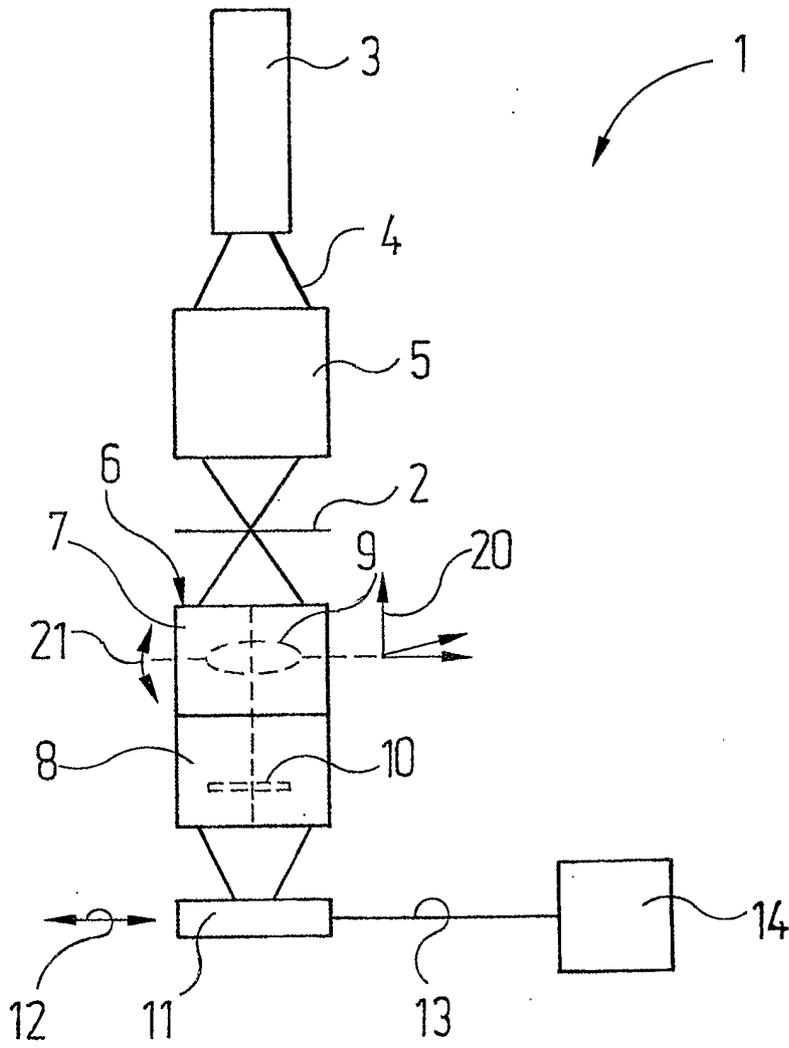


Fig.1

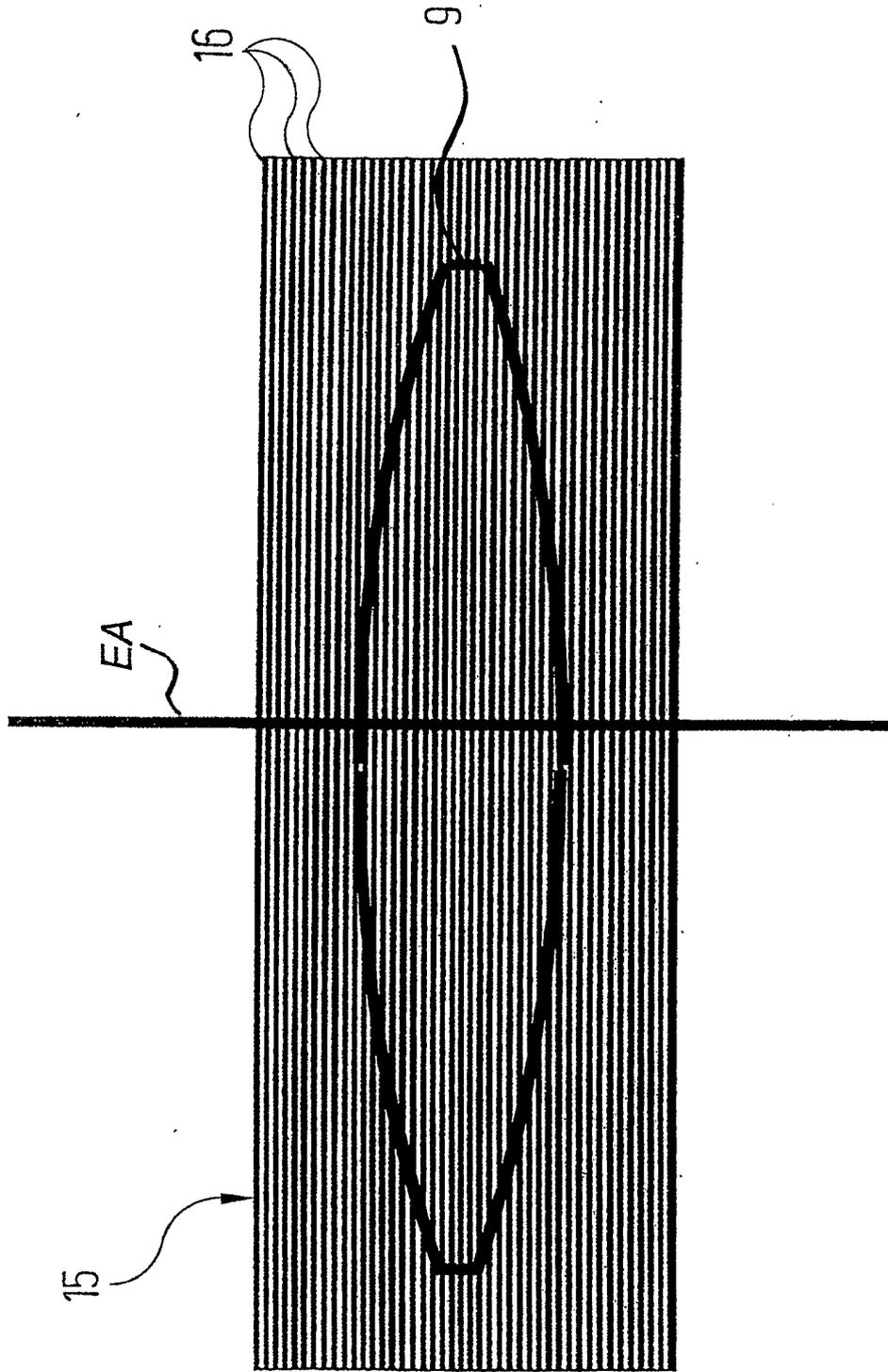


Fig. 2

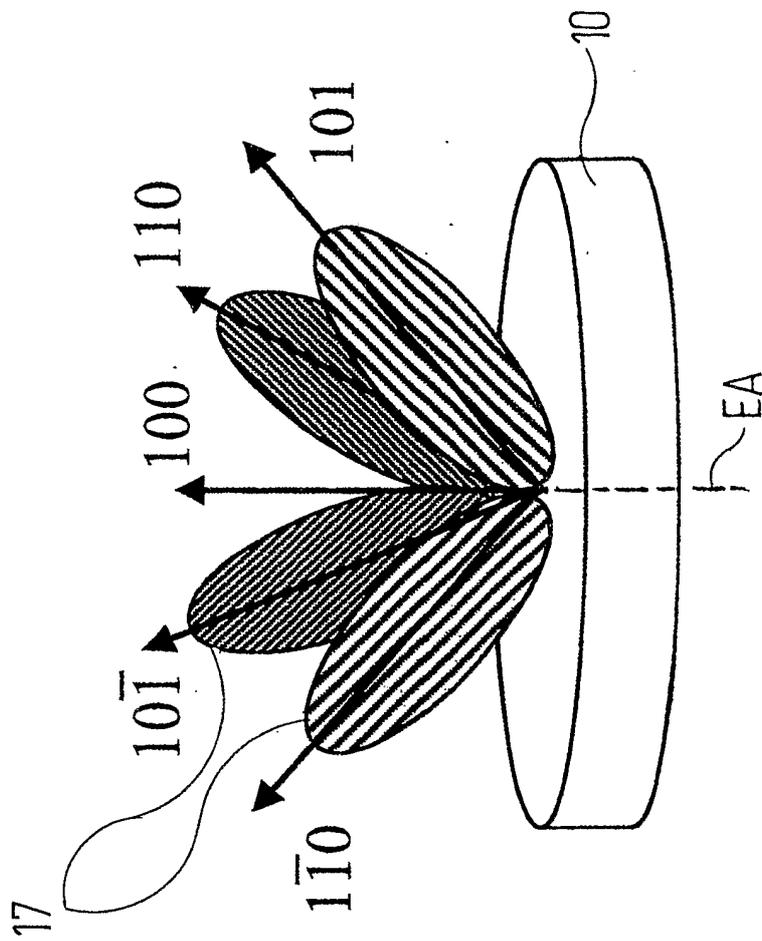


Fig. 3

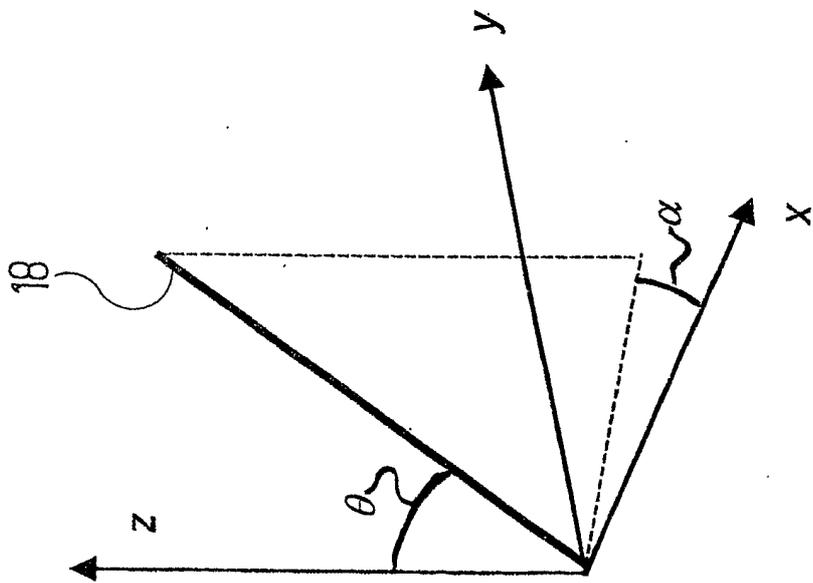


FIG. 4

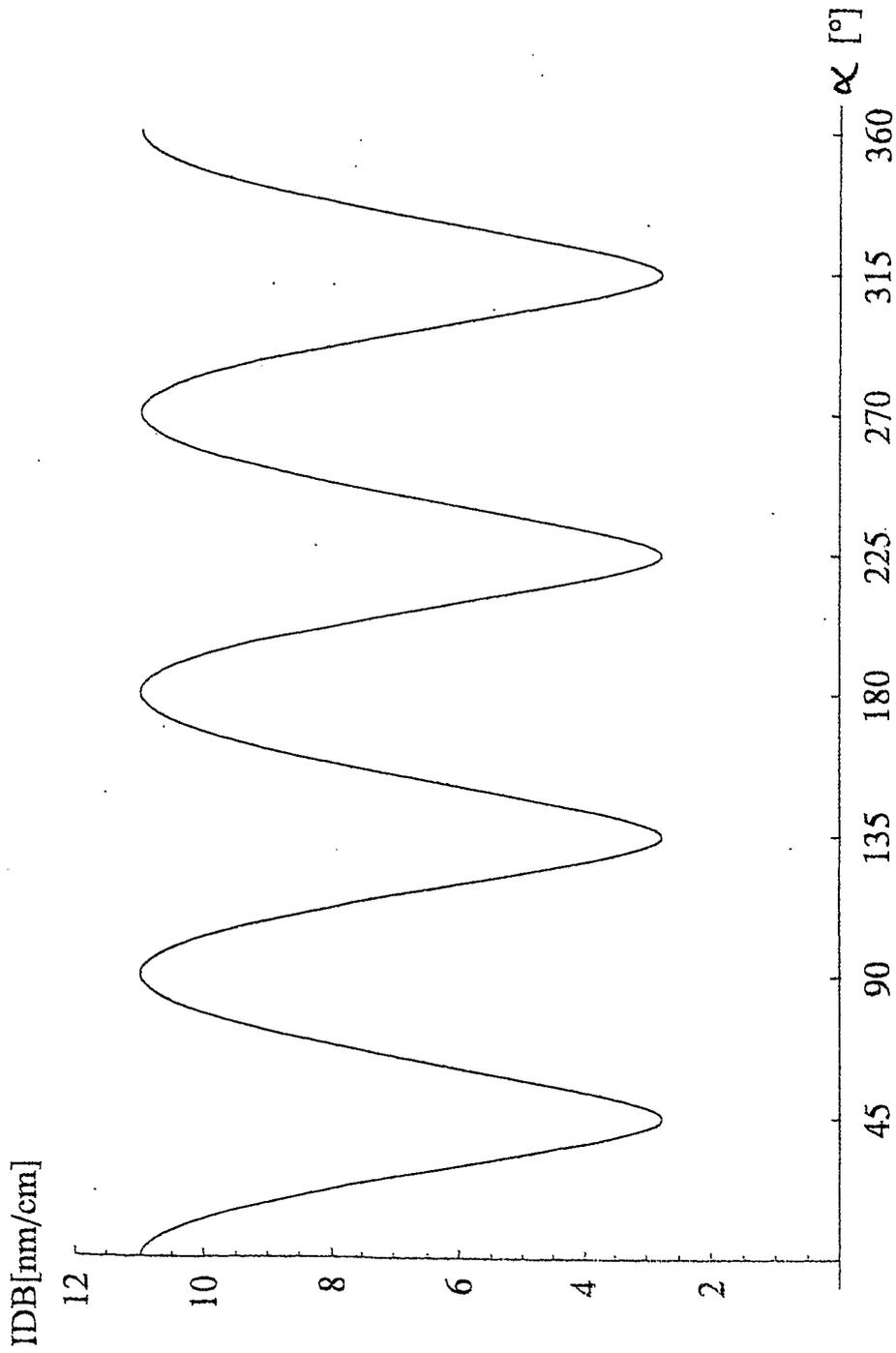


Fig. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 02/11030

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G03F7/20 G02B5/30 G02B1/02 G02B1/08				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03F G02B				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	EP 1 063 684 A (NIPPON KOGAKU KK) 27 December 2000 (2000-12-27) cited in the application abstract paragraph '0050! - paragraph '0053! paragraph '0096! - paragraph '0098! ---	1-10		
A	US 5 677 757 A (SHIRAISHI NAOMASA ET AL) 14 October 1997 (1997-10-14) column 19, line 46 -column 24, line 15 claims 8-14 ---	1-10		
A	US 6 057 970 A (CHOI SANG SOO ET AL) 2 May 2000 (2000-05-02) the whole document ---	1-10		
-/--				
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.				
° Special categories of cited documents :				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family </td> </tr> </table>			*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report			
11 April 2003	23/04/2003			
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer			
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	van Toledo, W			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 02/11030

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 252 712 B1 (F UURL RTER GERHARD ET AL) 26 June 2001 (2001-06-26) the whole document ----	1-10
A	US 4 701 606 A (ISHIZAKA SHOJI ET AL) 20 October 1987 (1987-10-20) column 2, line 27 -column 4, line 9 column 5, line 6 - line 15 ----	1-10
A	US 5 625 453 A (OHTSU YOSHIKI ET AL) 29 April 1997 (1997-04-29) abstract column 3, line 8 - line 20 -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intellectual Application No PCT/EP 02/11030
--

Patent document cited in search report	Publication date	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1063684	A	27-12-2000	AU 1891200 A	24-07-2000
			EP 1063684 A1	27-12-2000
			US 2002085176 A1	04-07-2002
			US 6366404 B1	02-04-2002
			CN 1293822 T	02-05-2001
			WO 0041226 A1	13-07-2000
US 5677757	A	14-10-1997	JP 7273005 A	20-10-1995
			JP 8008157 A	12-01-1996
			US 2002080338 A1	27-06-2002
			US 6333776 B1	25-12-2001
			US 6304317 B1	16-10-2001
			US 2002008863 A1	24-01-2002
US 6057970	A	02-05-2000	KR 269244 B1	01-12-2000
			JP 11354432 A	24-12-1999
US 6252712	B1	26-06-2001	DE 19807120 A1	26-08-1999
			EP 0937999 A1	25-08-1999
			JP 11271680 A	08-10-1999
			TW 403842 B	01-09-2000
US 4701606	A	20-10-1987	JP 1924607 C	25-04-1995
			JP 6052708 B	06-07-1994
			JP 61109053 A	27-05-1986
US 5625453	A	29-04-1997	JP 7190722 A	28-07-1995
			JP 3382389 B2	04-03-2003
			JP 7174517 A	14-07-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/11030

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G03F7/20 G02B5/30 G02B1/02 G02B1/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G03F G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 063 684 A (NIPPON KOGAKU KK) 27. Dezember 2000 (2000-12-27) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Absatz '0050! - Absatz '0053! Absatz '0096! - Absatz '0098! ---	1-10
A	US 5 677 757 A (SHIRAISHI NAOMASA ET AL) 14. Oktober 1997 (1997-10-14) Spalte 19, Zeile 46 - Spalte 24, Zeile 15 Ansprüche 8-14 ---	1-10
A	US 6 057 970 A (CHOI SANG SOO ET AL) 2. Mai 2000 (2000-05-02) das ganze Dokument --- -/--	1-10

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. April 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23/04/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

van Toledo, W

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 02/11030

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 252 712 B1 (F UUMLRTER GERHARD ET AL) 26. Juni 2001 (2001-06-26) das ganze Dokument -----	1-10
A	US 4 701 606 A (ISHIZAKA SHOJI ET AL) 20. Oktober 1987 (1987-10-20) Spalte 2, Zeile 27 - Spalte 4, Zeile 9 Spalte 5, Zeile 6 - Zeile 15 -----	1-10
A	US 5 625 453 A (OHTSU YOSHIKI ET AL) 29. April 1997 (1997-04-29) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 8 - Zeile 20 -----	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/11030

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1063684	A	27-12-2000	AU 1891200	24-07-2000
			EP 1063684	27-12-2000
			US 2002085176	04-07-2002
			US 6366404	02-04-2002
			CN 1293822	02-05-2001
			WO 0041226	13-07-2000
US 5677757	A	14-10-1997	JP 7273005	20-10-1995
			JP 8008157	12-01-1996
			US 2002080338	27-06-2002
			US 6333776	25-12-2001
			US 6304317	16-10-2001
			US 2002008863	24-01-2002
US 6057970	A	02-05-2000	KR 269244	01-12-2000
			JP 11354432	24-12-1999
US 6252712	B1	26-06-2001	DE 19807120	26-08-1999
			EP 0937999	25-08-1999
			JP 11271680	08-10-1999
			TW 403842	01-09-2000
US 4701606	A	20-10-1987	JP 1924607	25-04-1995
			JP 6052708	06-07-1994
			JP 61109053	27-05-1986
US 5625453	A	29-04-1997	JP 7190722	28-07-1995
			JP 3382389	04-03-2003
			JP 7174517	14-07-1995